

کنکور کارشناسی ارشد

تحلیل نظری مسائل الکترونیک

جلد اول

تألیف:

محمد صادق اسلام پنا (مدد)



انتشارات آزاده

- کلیه حقوق قانونی و شرعی برای ناشر محفوظ است.
- تکثیر تماماً یا قسمتی از این اثر به صورت حروفچینی، چاپ مجدد، چاپ افست، پلی کپی، فتوکپی و انواع دیگر چاپ ممنوع است.
- این اثر مشمول قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمی از این اثر را بدون اجازه ناشر، نشر، پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سری کتاب‌های

انتشارات آزاده

کنکور کارشناسی ارشد تحلیل نظری مسائل الکترونیک (جلد اول)

- تألیف: محمدصادق اسلام پناه سندی
- ناظر فنی و پیاپ: میر بدیع الدین
- طرح جلد: مهندس علی خبراء
- حروفچینی: انتشارات آزاده
- لیتوگرافی: نقره‌آبی
- چاپ و صحافی: امیرکبیر
- تیراز: ۱۰۰۰ نسخه
- چاپ ششم: بهار ۹۴، اول ۱۳۹۹
- ناشر: انتشارات آزاده
- شابک: ۲-۷۷۷-۵۰۱-۹۶۴-۹۷۸
- بها: ۹۸۰۰ تومان

مسئولیت مطالب کتاب به عهده مؤلف و حق پیاپ، ناشر، ناشر محفوظ است.

● مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، بین بست پورجوان، پلاک ۳، کد پستی: ۱۳۱۴۷۵۰۱۱
تلفن: ۰۲۱-۴۵۱۰-۶۶۴۱۵۷۵۳ - ۰۲۱-۴۳۷۴ - ۰۲۱-۹۶۴۱۴۳۷۴ فاکس:

سرشاسه	: اسلام پناه سندی، محمدصادق
عنوان و پدیدآور	: تحلیل نظری مسائل الکترونیک / محمدصادق اسلام پناه سندی
مشخصات نشر	: تهران: آزاده، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری	: ج: ۱: ۵۶۴ ص.
فروست	: کنکور کارشناسی ارشد. سری کتاب‌های راهیان ارشد.
شابک	: ج: ۱: ۲-۷۷۷-۵۰۱-۹۶۴-۹۷۸
و ضعیت نهرستنویسی	: فیلیا مختصر
رده‌بندی دیوبی	: ۶۲۱/۳۸۱۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۶۲۶۲۰۱

برای خرید *online* به آدرس زیر مراجعه کنید:

www.rahianarshad.com

یادداشت ناشر

«سری کتاب‌های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد» در بیش از ۳۰۰ جلد، حاصل تلاش فراوان، دقت نمایند و انتقال دانش و تجربه بیش از یکصد نفر از نیروهای جوان و متخصص با تحصیلات عالی دانشجویی را در دانشگاه‌های معتبر صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی شریف و تهران با تجربه تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات برتر کنکوری می‌باشد. در این مجموعه، سعی شده تا با بهره‌گیری از کادر فنی مجروب نشر، کیفیت کار ارزشی علمی و فنی بالا برد و به ویژه از نظر حروفچینی و صفحه‌بندی متن، کتاب را نسبت به موارد مشابه متمام نماییم.

با توجه به نکات یاد شده، من بینه، می‌شدم که راهیان کنکور کارشناسی ارشد با مطالعه این مجموعه، ضمن صرفه‌جویی در وقت برای تهیه مراجع، تبریز، با مفاهیم و نکات ضروری مفیدی آشنا شوند که این مهم، با توجه به استقبال خوب و تماس‌های تسلیک‌آهنگ و اراده دان محترم در این مدت، بر ما مشخص شد.

راهیان ارشد اولین سعی و تلاش سبک خود وده برای ارائه مجموعه کاملی از بهترین خلاصه درس‌ها، نکات کاملاً ویژه کنکوری و تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی سال‌ها کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی براساس سرفصل‌های مصوب شورای عالی تربیت و همچنین سرفصل‌های متداول در دانشگاه‌ها، که به عنوان مرجعی معتبر برای استفاده داوطلبان کنکور و دانشجویان ای سراسری و آزاد (برای اولین بار) به بازار عرضه شده است.

انتشارات آزاده از کلیه عزیزانی که به هر نوعی در تولید و توزیع این مجموعه سعی داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و نیز کلیه کاستی‌ها و اشکالات موجود را بر عهده می‌گیرد و به همین منظور و برای رفع آن‌ها، در انتظار دریافت نظرات انتقادی از استادان گرانقدر، دانشجویان و دیگر خوانندگان این مجموعه و حتی همکاران است.

مدیر انتشارات آزاده

جمفر بدوسنانی

فهرست مطالب

۱۳	فصل اول: دیود
۱۵	۱ - ۱ - ۱ - پیوند فیزیک نیمه هادی دیود
۱۶	۱ - ۱ - ۲ - پیوند PN در بایاس مستقیم
۱۷	۱ - ۲ - پیوند PN در بایاس معکوس
۱۷	۱ - ۲ - مدار مداره دیود
۱۷	۱ - ۲ - ۱ - مدل ایدهآل
۱۸	۱ - ۲ - ۲ - مدل واندر ثابت
۱۸	۱ - ۲ - ۳ - مدار تکه خان
۱۹	۱ - ۲ - ۴ - مدل واندی
۲۲	۱ - ۳ - مدل سیگنال کوچک دیود
۲۴	۱ - ۴ - کاربردهای دیود
۲۴	۱ - ۴ - ۱ - یکسو کننده های نیم مو
۲۶	۱ - ۴ - ۲ - مدار دیود - خازن
۲۹	۱ - ۴ - ۳ - یکسوزار تمام موچ
۳۱	۱ - ۴ - ۴ - مدار تغییر سطح دهنده DC
۳۴	۱ - ۴ - ۵ - مدار دو برابر کننده ولتاژ
۳۶	مسائل تشریحی فصل اول
۳۹	پاسخ مسائل تشریحی فصل اول
۵۳	تست های کنکور کارشناسی ارشد فصل اول
۶۳	پاسخ تست های کنکور کارشناسی ارشد فصل اول
۷۸	تست های تکمیلی فصل اول
۸۰	پاسخنامه تست های تکمیلی فصل اول
۸۱	فصل دوم: ترانزیستور دوقطبی
۸۲	۲ - ۱ - مفهوم ترانزیستور
۸۲	۲ - ۲ - نماد مداری
۸۲	۲ - ۳ - ساختمان فیزیکی
۸۳	۲ - ۴ - نواحی عملکرد ترانزیستور دو قطبی
۸۴	۲ - ۴ - ۱ - عملکرد ترانزیستور NPN در ناحیه فعال
۸۵	۲ - ۴ - ۲ - عملکرد ترانزیستور NPN در ناحیه اشباع
۸۵	۲ - ۵ - اثر ارلی

۸۶	۲-۶- جریانهای I_{CEO} و I_{CBO} ۲
۸۶	۲-۷- تحلیل DC مدارهای ترانزیستور دو قطبی ۲
۹۵	۲-۸- بررسی شرایط صرفه نظر کردن از جریان بیس ۲
۹۷	۲-۹- تقویتکنندههای سیگنال ۲
۹۸	۲-۱۰- مدل سیگنال کوچک ترانزیستور دو قطبی ۲
۱۰۰	۲-۱۱- تحلیل نظری ۲
۱۰۴	۲-۱۲- بررسی چند مدار مهم ۲
۱۰۴	۲-۱۲-۱- مدار دارلینگتون ۲
۱۰۵	۲-۱۲-۲- مدار ضربکننده ولتاژ V_{BE} ۲
۱۰۸	۲-۱۳- بررسی تغییر میلر ۲
۱۱۳	۲-۱۴- مآریم سوئینگ ولتاژ خروجی ۲
۱۲۰	مسائل نششی فصل دم ۲
۱۲۴	پاسخ مسائل نششی فصل دوم ۲
۱۸۷	تستهای کنکور کارشناسی ارشد فصل دوم ۲
۲۰۹	پاسخ تستهای کنکور کارشناسی ارشد فصل دوم ۲
۲۴۵	تستهای تکمیلی فصل دوم ۲
۲۵۰	پاسخنامه تستهای تکمیلی فصل دوم ۲
۲۵۱	فصل سوم: ترانزیستور اثر میدان ۳
۲۵۳	۳-۱- تقسیم‌بندی ترانزیستورهای اثر میدان ۳
۲۵۴	۳-۲- بررسی ساختار فیزیکی MOSFET‌های افزایشی ۳
۲۵۷	۳-۳- تحلیل DC مدارهای MOSFET ۳
۲۶۲	۳-۴- بررسی ساختار JFET ۳
۲۶۶	۳-۵- تقویتکنندههای FET ۳
۲۶۷	۳-۶- مدل سیگنال کوچک FET ۳
۲۶۸	۳-۷- تحلیل نظری تقویتکنندههای FET ۳
۲۷۳	۳-۸- مدار ضربکننده ولتاژ گیت - سورس ۳
۲۷۶	مسائل تشریحی فصل سوم ۳
۲۸۳	پاسخ مسائل تشریحی فصل سوم ۳
۳۱۱	تستهای کنکور کارشناسی ارشد فصل سوم ۳
۳۲۴	پاسخ تستهای کنکور کارشناسی ارشد فصل سوم ۳
۳۴۹	تستهای تکمیلی فصل سوم ۳
۳۵۴	پاسخنامه تستهای تکمیلی فصل سوم ۳

فصل چهارم: منابع و آینه‌های جریان.....	۳۵۵
۴ - ۱ - بررسی مدارهای آینه جریان با <i>BJT</i>	۳۵۷
۴ - ۱ - آینه جریان ساده.....	۳۵۷
۴ - ۱ - ۲ - مدار بهبود یافته آینه جریان ساده.....	۳۶۱
۴ - ۱ - ۳ - بررسی آینه جریان ویلسون.....	۳۶۴
۴ - ۱ - ۴ - آینه جریان کسکود.....	۳۶۶
۴ - ۲ - بررسی مدارهای آینه جریان با <i>FET</i>	۳۶۸
۴ - ۲ - ۱ - مدار آینه جریان ساده.....	۳۶۸
۴ - ۲ - ۲ - مدار آینه جریان ویلسون.....	۳۷۰
۴ - ۲ - ۳ - مدار آینه جریان کسکود.....	۳۷۱
۴ - ۳ - بررسی مدارهای بینه ج دای در حالتی که ترانزیستورها مشابه نباشند.....	۳۷۲
۴ - ۴ - بررسی مدارهای متنا- جریان.....	۳۷۶
۴ - ۴ - ۱ - مدار ویدلر.....	۳۷۶
۴ - ۴ - ۲ - منع جریان اوج دار.....	۳۷۹
مسائل تشریحی فصل چهارم.....	۳۸۱
پاسخ مسائل تشریحی فصل چهارم.....	۳۸۸
تست‌های کنکور کارشناسی ارشد فصل چهارم.....	۴۰۳
پاسخ تست‌های کنکور کارشناسی ارشد فصل چهارم.....	۴۱۲
تست‌های تکمیلی فصل چهارم.....	۴۲۵
پاسخنامه تست‌های تکمیلی فصل چهارم.....	۴۳۲
فصل پنجم: تقویت‌کننده تفاضلی.....	۴۳۳
۵ - ۱ - اهمیت تقویت‌کننده تفاضلی.....	۴۳۴
۵ - ۲ - تحلیل کیفی تقویت‌کننده تفاضلی.....	۴۳۵
۵ - ۳ - تحلیل کمی تقویت‌کننده تفاضلی <i>BJT</i>	۴۳۷
۵ - ۴ - ۱ - عملکرد سیگنال بزرگ.....	۴۳۷
۵ - ۴ - ۲ - عملکرد سیگنال کوچک.....	۴۳۹
۵ - ۴ - ۳ - تحلیل کمی تقویت‌کننده تفاضلی <i>FET</i>	۴۴۲
۵ - ۴ - ۴ - عملکرد سیگنال بزرگ.....	۴۴۲
۵ - ۴ - ۵ - عملکرد سیگنال کوچک.....	۴۴۴
۵ - ۵ - تحلیل نظری تقویت‌کننده تفاضلی	۴۴۶
۵ - ۵ - ۱ - محاسبه بهره تفاضلی	۴۴۶
۵ - ۵ - ۲ - محاسبه بهره حالت مشترک	۴۴۸
۵ - ۶ - مقاومت ورودی	۴۵۱

۴۵۱	۱ - مقاومت تفاضلی ورودی ۵
۴۵۲	۲ - مقاومت حالت مشترک ورودی ۵
۴۵۳	۷ - نسبت در حالت مشترک ۵
۴۵۴	۸ - تفاضلی با بار فعال ۵
۴۵۷	۹ - محاسبه بهره سیگنال تفاضلی ۵
۴۶۰	۱۰ - محاسبه بهره سیگنال حالت مشترک ۵
۴۶۲	۱۱ - آفست در تفاضلی ۵
۴۶۶	مسائل تشریبی فصل پنجم ۵
۴۷۴	۱ - مسائل تشریبی فصل پنجم ۵
۵۰۷	تسهای کنکور کارشناسی ارشد فصل پنجم ۵
۵۲۲	پاسخ تست‌های کنکور کارشناسی ارشد فصل پنجم ۵
۵۵۲	تست‌های تکمیلی ۵
۵۶۲	پاسخناه تکمیلی ۵